

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN  
CHỨC DANH: Phó giáo sư  
Mã hồ sơ:.....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:  ; Nội dung không đúng thì để trống: )

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thị Thúy

2. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1986; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Căn hộ A2112, Chung cư Miproc Rubik 360, số 122-124 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ A2112, Chung cư Miproc Rubik 360, số 122-124 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0986525936;

E-mail: nguyenthuy@hnue.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 03,2012 đến tháng, năm 06,2023: Giảng viên tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02437537797

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không có

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 09 tháng 06 năm 2009, số văn bằng: A330235, ngành: Vật lý, chuyên ngành: SP Vật lý - Chất lượng cao

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 02 tháng 04 năm 2013, số văn bằng: QM 015362, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý vô tuyến điện tử

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Được cấp bằng TS [5] ngày 23 tháng 03 năm 2018, số văn bằng: 7543, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật liệu điện tử

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

13.1. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất vật lý của màng mỏng bán dẫn được tinh thể hóa bằng laser và các linh kiện màng mỏng bán dẫn nhiệt độ thấp

13.2. Nghiên cứu vật liệu Meta hấp thụ sóng điện từ (metamaterials)

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 21 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giấy khen	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2021

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

## B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Với vai trò là một nhà giáo, tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luôn tuân thủ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường. Có trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một giảng viên. Luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, tôn trọng và đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn tự ý thức phát triển bản thân, trau dồi kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa, các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Về hoạt động đào tạo bậc đại học, tôi tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành cho hệ cử nhân sư phạm vật lí, cử nhân sư phạm vật lí chất lượng cao, và cử nhân sư phạm vật lí (dạy vật lí bằng Tiếng Anh). Hằng năm tôi hướng dẫn nhiều sinh viên bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Về hoạt động đào tạo sau đại học, tôi tham gia giảng dạy học phần “Vật liệu và linh kiện tiên tiến” cho học viên chuyên ngành Vật lí chất rắn, khoa Vật lí, hướng dẫn các học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Về nghiên cứu khoa học, tôi luôn ý thức rằng nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên phục vụ công tác đào tạo bậc đại học, vì vậy tôi luôn cập nhật những thông tin khoa học mới, kết nối, chia sẻ, và trao đổi nghiên cứu với cộng đồng khoa học trong cùng lĩnh vực, xây dựng nhóm nghiên cứu, và thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế. Tôi đã chủ trì triển khai một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và một đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Nafosted. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi đã tích cực tham gia các công việc chung của Khoa và nhà trường, tham gia phát triển chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lí và chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lí (dạy vật lí bằng Tiếng Anh).

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 8 năm 4 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2014-2015					290		290/290/280
2	2018-2019				4	305		305/462.5/270
3	2019-2020			1	3	120	45	165/357.5/135 (Chế độ thai sản)
03 năm học cuối								
4	2020-2021			1	3	265	45	310/552.5/270
5	2021-2022				4	250	45	295/507.5/270
6	2022-2023				3	400	45	445/412.5/310

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

### 3. Ngoại ngữ

#### 3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: Nhật Bản năm 2018

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Phạm Thị Dung		X	X		12/2020 đến 12/2021	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	30/12/2021
2	Nguyễn Thị Huyền		X	X		12/2019 đến 08/2020	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	18/01/2021

**Ghi chú:** Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

**Lưu ý:**

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện của linh kiện điện tử nhiệt độ thấp ứng dụng cho mạch tích hợp 3D	CN	B2018-SPH-05-CTVL, cấp Bộ	01/10/2018 đến 18/06/2021	18/6/2021/ Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	<a href="#">Influence of structural parameters on a novel metamaterial absorber structure at K-band frequency</a>	3	Không	Journal of Electronic Materials	QTUT - SCIE IF: 2.047, Q3	8	45 2591	03/2016
2	<a href="#">Creating a Multiband Perfect Metamaterial Absorber at K Frequency Band Using Defects in the Structure</a>	4	Không	Journal of Electronic Materials	QTUT - SCIE IF: 2.047, Q3	4	46 413	08/2016

3	<a href="#">Ultrahigh-performance poly-Si thin film transistor using multi-line beam continuous-wave laser lateral crystallization</a>	4	Có	Proceeding of the 23rd International Workshop on Active-Matrix Flat panel Displays and Devices		1	277	07/2016
4	<a href="#">Characterization of (100)-Dominantly Oriented Poly-Si Thin Film Transistors Using Multi-Line Beam Continuous-Wave Laser Lateral Crystallization</a>	4	Có	ECS Transactions	QTUT - Scopus <i>IF</i> : 0.64, <i>Q4</i>	1	75, 10, 49	06/2016
5	<a href="#">Ultrahigh-performance (100)-oriented polycrystalline silicon thin-film transistors and their microscopic crystal structures</a>	3	Có	Applied Physics Express	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 2.819, <i>Q2</i> ( <i>Q1 ở thời điểm đăng</i> )	24	10, 5, 056501	04/2017
6	<a href="#">Back-side Illuminated GeSn Photodiode</a>	7	Không	Proceeding of 2017 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)		8	16.3.1	12/2017

	<a href="#">Array on Quartz Substrate Fabricated by Laser-induced Liquid-phase Crystallization for Monolithically-integrated NIR Imager Chip</a>							
7	<a href="#">Formation of (100)-oriented large polycrystalline silicon thin films with multiline beam continuous-wave laser lateral crystallization</a>	5	Có	Japanese Journal of Applied Physics	QTUT - SCIE IF: 1.491, Q3	14	57, 3, 031302	02/2018
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
8	<a href="#">Simulation of metal via-wall based ultra-broadband terahertz full-sized metamaterial absorber</a>	5	Không	HNUE Journal of Science: Natural Science			63, 11, 65	11/2018
9	<a href="#">Power dependence of polycrystalline silicon thin film crystallinities with multiline</a>	6	Có	HNUE Journal of Science: Natural Science			64, 10, 94	10/2019



	<a href="#">beam continuos-wave laser lateral crystallization</a>							
10	Ultrahigh- performance Poly-Si thin film transistors and their perspective applications	4	Có	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2019			2 785	11/2019
11	Nghiên cứu vật liệu Meta hấp thụ hoàn toàn sóng điện từ thang GHz theo cơ chế tối ưu khuyết mạng dạng cột	6	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2019			1 246	11/2019
12	<a href="#">Creating multiband and broadband metamaterial absorber by multiporous square layer structure</a>	6	Không	Plasmonics	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 2.726, Q3	25	14 1587	05/2019
13	<a href="#">Dependence of thin film transistor characteristics on low-angle grain boundaries of (100)-oriented polycrystalline</a>	2	Có	Japanese Journal of Applied Physics	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 1.491, Q3	11	58, SB, SBBJ08	03/2019

	<a href="#">silicon thin films</a>							
14	<a href="#">Broadband microwave coding metamaterial absorbers</a>	10	Không	Scientific Reports	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 4.997	44	10 1810	02/2020
15	<a href="#">Study electromagnetic wave interaction of active-matrix thin film transistors</a>	4	Có	HNUE Journal of Science: Natural Science			65, 10, 24	10/2020
16	<a href="#">Characterization of selectively oriented polycrystalline silicon thin films formed by multiline beam continuous-wave laser lateral crystallization with overlapping</a>	7	Có	Japanese Journal of Applied Physics	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 1.491, Q3	3	59, 11, 115504	11/2020
17	<a href="#">Characterization of Continuous-Wave Laser Crystallized Silicon Thin Films with Hole-Patterns</a>	2	Có	ECS Journal of Solid State Science and Technology	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 2.483, Q3		11, 5, 055001	05/2022
18	<a href="#">Void-Defect Location</a>	3	Có	VNU Journal of Science:			38, 4, 93	12/2022

	<a href="#">Control of Laser-Crystallized Silicon Thin Films with Hole-Pattern</a>			Mathematics-Physics				
19	Extending the Absorption Frequency Band Using Twisted Configuration in the GHz Region	7	Không	Progress in Electromagnetics Research Letters	QTUT - ESCI <i>IF</i> : 1.036, Q3		105 71	07/2022
20	Ứng dụng thuật toán tiến hóa (GA) nghiên cứu chế tạo bề mặt vật liệu biến hóa metasurface hấp thụ sóng điện từ dải rộng vùng GHz	9	Không	Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2021			2 558	08/2022
21	<a href="#">Nanowire single-crystal grain and single grain boundary silicon field effect transistors for direct electrical characterization of grain boundaries</a>	3	Có	Applied Physics Express	QTUT - SCIE <i>IF</i> : 2.819, Q2		16, 2, 205502	02/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 4 ( [13] [16] [17] [21] )

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
----	------------------------	------------	------------------	---	---	----------------	--------------------

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
----	--	-----------------	--------------------	-----------------------------	------------

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
----	--	---------------------------	--	----------------------------------	------------

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
----	---	--------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	---------

Không có

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế\*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

*Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.*

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

### **C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm  
2023**

**Người đăng ký  
(Ký và ghi rõ họ tên)**